

ЭФЕНДИЕВА ИЗЗЕТ МАМЕД кызы

ЭФЕНДИЕВА ИЗЗЕТ МАМЕД кызы

Доктор наук по физике,
Профессор (0,5 шт.) кафедры «Физическая электроника»
Начальник Научно-Исследовательской Части Бакинского Государственного
Университета.

Раб.тел.: +(994 012) 539-73-73; +(994 012) 510-59-77.

e-mail: elmi_hisse@mail.ru, afandiyeva@mail.ru

Краткая биографическая справка:

- Родилась 10 сентября 1950 г. в г.Гянджа, азербайджанка.
- 1967-1972-гг. – студентка русского сектора физического факультета Бакинского Государственного Университета.
- 1972-1974 гг. – преподаватель физики в школе №17 Управления Железных дорог (г.Гянджа).
- 1974-1977 гг. – инженер Специального Конструкторского Бюро Института Физики Академии Наук Азерб.ССР.
- 1977-1989 гг. – м.н.с. Научно-Исследовательской Лаборатории Физики Полупроводников (в настоящее время НИИ Проблем Физики) Бакинского Государственного Университета.
- 1989-1997 гг. - руководитель группы по делам изданий и выставок Научно-Исследовательской Части БГУ, заместитель 1-го проректора.
- 1997-2018-гг. – с.н.с., вед.н.с., главн. н.сотр. НИИ Проблем Физики Бакинского Государственного Университета.
- 2012г. по настоящее время начальник Научно-Исследовательской Части Бакинского Государственного Университета.
- 17.09.2018- профессор (0,5 шт) кафедры «Физическая электроника»
- 1992-1997гг. - Ответственный Секретарь Главной Редакции Журнала «Вестник Бакинского Университета».
- 1989-2005гг. - Член Президиума Научно-Технического Общества Радиотехники, Электроники и Связи Азербайджанской Республики.

С 2007-го года является членом политической Партии «Новый Азербайджан».

Автор 104 научных публикаций.

Научное руководство:

М.А.Ганбарзаде (Иран);
Л.К. Абдуллаева (БГУ)

ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

- 1972 г. – Физический факультет Бакинского Государственного Университета, специальность – физик, преподаватель физики.

- 1991 г. - Отделение Менеджмента и Бизнеса Института Молодежи (Баку), специальность - «Организация и техника внешнеэкономической деятельности» .
- 1987 г. - защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук по теме “Оптические свойства и электронное строение полярных диэлектриков – сложных окислов на основе переходных элементов” по специальности Физика полупроводников и диэлектриков-01.04.10 (г. Баку, Бакинский Государственный Университет).
- 2013 г. – защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук по физике по теме «Электро-физические параметры, электронная структура и механизмы переноса контактов металл-полупроводник Al-TiW-PtSi/n-Si, Al-TiW-Pd₂Si/n-Si, Al-TiW/n-Si, AlNi/n-Si, Al-TiCu/n-Si» по специальности физика твердого тела-2211-01 (г. Баку, Бакинский Государственный Университет).
- 2009 г. – ученое звание доцента по специальности «Физика полупроводников и диэлектриков».

Научные интересы:

физика твердого тела, физика полупроводников и диэлектриков, контакт металл-полупроводник, наноэлектроника

Зарубежные командировки

Россия, Ураина, Белоруссия, Литва, Латвия, Иран, Турция

Участие на Международных конференциях:

14-th RE Research Conference, North Dacota State Univ., USA,(ABŞ1979; Россия,Черноголовка, 1981; Malaga, Spain (Испания) 1983; Россия, Иркутск, 1989; International Conference on Solar Energy and the Islamic countries (SEIC), Iran, Tehran (Иран) 1995; 2 International Non-Renewable Energy Sources Congress Tehran, Iran (Иран) 1998; International Conference on Fluid and Thermal Energy Conversion, Indonesiya, Bandung (Индонезия) 2000; The 23 Conference on Solid State Science & Workshop on Physics and Application Potential of Functional Ceramic, Thin Films, Sharm El-Sheikh, Sinai.,Egypt(Египет) 2002; X1 Yoğun Madde Fiziği, Ankara Toplantısı (Турция)2004; Türk Fizik Dernegi 23.Fizik Kongresi, 2005, Muğla-Türkiye ; Atom-Molekul ve çekirdek sistemlerinin yapıları ve spektrumları, Uluslara.Konf., Canak-kale, 18 mart Universitesi(Турция) 2005; Third Intern. Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara (Турция) 2006; 6-th International Conference of the Balkan Physical Union (BPU-6), , Stanbul (Турция)2006; Condensed Matter Phys Conference of Balkan Countries смрс- bc2008, Mugla(Турция).

Участие в выставках

Организатор экспозиций «Научные разработки ученых БГУ» на выставках Международного (1991-1992 гг.) и Республиканского (2014,2016,2018) значения.

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ:

1. Mamedov A.M, Lebedeva N.N., Efendieva İ.M. “Domain Structure and Optical Properties of Gadolinium Molibdate”, 14-th RE Research Conference, Jun. 25-28, 1979,

- North Dakota State Univ., USA, 1979.**
2. Mamedov, AM; Shilnikov, VI; Efendieva I.M. «Analysis of $\text{Ba}_2\text{NaNb}_5\text{O}_{15}$ reflection spectra by the Kramers-Kronig method» *Optika I Spektroskopiya*, v.53, i.1, p.5-7, 1982
 3. Mamedov M.A., Osman M.A., Efendieva I.M. “VUV spectra and electron structure of oxygen-tetrahedral ferroelectrics” **V European Meeting on Ferro-electricity.** (Abstracts), **Malaga, Spain**, p.4014, 1983.
 4. Osman MA., Mamedov AM., Efendieva I.M. ” Light-scattering in Gadolinium Molybdate due to domain-structure” **Journal of physics-condensed matter**, v. 2, i.28, 1989.“
 5. Afandiyeva I.M., Askerov Sh.G., Abdullayeva L.K., Aslanov Sh.S. The obtaining of Al-Ti₁₀W₉₀/n-Si Schottky diodes and investigation of their interface surface state density. **Solid State Electronics**, 51, 2007, p.1096.
 6. Эфендиева И.М., Аскеров Ш.Г., Абдуллаева Л.К., Агаев М.Н., Гасанов М.Г. Электронные свойства границы раздела диодов Al_{0,8}Ni_{0,2}/n-Si. **Fizika**, XIII, №3, 2007, s. 62.
 7. Afandiyeva I.M., Dökme İ., Altındal Ş., Bülbül M., Tataroğlu A. Frequency and voltage effects on the dielectric properties and electrical conductivity of Al-TiW-Pd₂Si/n-Si structures. **Microelectronic Engineering**, 85, 2008, p.247.
 8. Afandiyeva I.M., Dökme İ., Altındal Ş., Askerov Sh.G., Abdullayeva L.K. The frequency and voltage dependent electrical characteristics of Al-TiW- Pd₂Si/n-Si structure using I-V, C-V and G/ω-V measurements. **Microelectronic Engineering**. 85, 2008, p.365.
 9. Dökme İ., Altındal Ş., Afandiyeva I.M. The distribution of the barrier height in Al-TiW-Pd₂Si/n-Si Schottky diodes from I-V-T measurements. **Semiconductor Science and Technology**. 23, 2008, 1.
 10. Эфендиева И.М., Определение эффективной толщины зазора КМП с поликристаллическим металлическим слоем. **Труды Международной Конференции “Научно-технический прогресс и современная авиация “**, Баку, февр.2009. с.311.
 11. Эфендиева И.М. Исследование электрофизических параметров контактов металл-полупроводник Al-TiCu/n-Si с поликристаллической металлической пленкой. **Известия НАН Азербайджанской Республики , Серия физ.-мат.наук.** XXX, №2, 2010, с.118.
 12. Эфендиева И.М., Фрактальные исследования границы раздела КМП Al-TiCu/n-Si. **Journal of Qafqaz University**, vol.1, 29, 2010, с. 86.
 13. Üslü H., Altındal Ş., Aydemir U., Dökme İ., Afandiyeva I.M. The interface states and series resistance effects on the forward and reverse bias I-V, C-V and G/ ω -V characteristics of Al-TiW-Pd₂Si/n-Si Schottky barrier diodes. **Journal of Alloys and Compounds**, 503, 2010, p. 96.
 14. Üslü H., Dökme İ., Altındal Ş., Afandiyeva I.M., Illumination effect on I-V, C-V and G/ ω -V characteristics of Al-TiWPd₂Si/ n-Si structures at room temperature. **Surface and Interface Analysis**. 42, 2010, p.807.
 15. Afandiyeva I.M. , Özçelik S, Abdullayeva L.K. Photoluminescence study of metal film’s impact on silicon energetic structure. **Journal of Qafqaz University**, vol.1, 29, 2010, p. 96.
 16. Afandiyeva I.M. The temperature, frequency and voltage dependent characteristics of Al-TiW-Pd₂Si/n-Si structure using I – V, C – V and G / ω – V measurements. **Azerbaijan Journal of Physics - Fizika**, XVI, 3-4, 2010, p.102.
 17. Afandiyeva I.M. Frequency, voltage and temperature effects on the inductive properties of Al-TiW-PtSi/n-Si Schottky diodes. **Известия НАН Азербайджанской Республики , Серия физ.-мат.наук.** XXXI, №2, 2011, с. 29.
 18. Afandiyeva I.M., M.Bülbül, Ş.Altındal, S.Bengi. Frequency dependent dielectric

- properties and electrical conductivity of Platinum silicide/Si contact structures with diffusion barrier. **Microelectronic Engineering**, **93**, 2012, p. 50.
19. I.M. Afandiyeva, S. Demirezen, S. Altındal. Temperature dependence of forward and reverse bias current–voltage characteristics in Al–TiW–PtSi/n-Si Schottky barrier diodes with the amorphous diffusion barrier. **Journal of Alloys and Compounds**, 552 (2013)p. 423–429.
 20. Afandiyeva I.M, Ş. Altındal, E. Maril, T. Z. Guliyeva et al. “The investigation of tunnel properties of Al-TiW-PtSi/n-Si (111)(MS) Schottky barrier diodes (SBDs) in the wide temperature range” **Journ. of Qafgaz University**, vol.2 , N2 , 2014, p. 107-118.
 21. И.М. Эфендиева, Л.К.Абдуллаева, Т.З.Кулиева, и др. «АС-проводимость диодов Шоттки Al-TiW-PtSi/n-Si» **Journ. of Qafgaz University**, 2015,v.3, N 1. P.49-52.
 22. I.M.Afandiyeva, Ş. Altındal, L. K. Abdullayeva et.al. “The frequency and voltage dependent of C-V and G/w-V of Al- TiW-PtSi/n-Si structures at room temperature” **Journ. of Qafgaz University**, 2015,v.3, N 2. P.105-111.
 23. Afandiyeva İ.M., Askerov Sh. G., Abdullayeva L.K.,et al. “İllumination dependent I-V characteristics of PtSi/n-Si(111) Schottky barrier diodes (SBDS) at room temperature” **Journ. of Qafgaz University**, 2016,v.4 №2, p.106-114.
 24. I.M.Afandiyeva, L.K.Abdullayeva, T.Z.Guliyeva, SH.M.Gojayeva “Influence of Illumination on Dielectric Properties of Al-TiW-PtSi/n-Si Schottky Diodes “Baku, Int Confr, “ **Modern trends in Physics**”22 april 2017,p.33-37,(Baku, Fizfak,2017)
 25. I.M. Afandiyeva, Ş. Altındal, L.K. Abdullayeva “İllumination dependent electrical characteristics of PtSi/n-Si(111) Schottky barrier diodes (SBDs) at room temperature “**J. Modern Technology & Engineering** Vol.2, No.1, 2017, pp.43-56.
 26. I.M. Afandiyeva , Ş. Altındal , L.K.Abdullayeva, A.İ.Bayramova ““ Self-assembled patches in PtSi/n-Si(111) diodes" **J. Semicond.** 2018, 39 054002